

## 关于《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》 等三项团体标准立项的通知

各有关单位：

由广州南砂晶圆半导体技术有限公司的《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》以及由工业和信息化部电子第五研究所牵头的《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法》、《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）热阻电学法测试方法》三项团体标准提案，经 CASA 标准化委员会（CASAS）管理委员会审核，根据《CASA 管理和标准制修订细则》，《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》、《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法》、《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）热阻电学法测试方法》三项提案立项通过，分配编号为：CASA 014、CASA 015、CASA 016。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟



附件：评审单位

排名不分先后

1	北京大学
2	大连芯冠科技有限公司
3	第三代半导体产业技术创新战略联盟
4	东莞市天域半导体科技有限公司
5	东旭集团有限公司
6	德豪润达电气股份有限公司
7	河北同光晶体有限公司
8	南京大学
9	全球能源互联网研究院
10	三安光电股份有限公司
11	厦门华联电子股份有限公司
12	山东大学
13	苏州能讯高能半导体有限公司
14	泰科天润半导体科技（北京）有限公司
15	浙江大学
16	中电科电子装备集团有限公司
17	中国电子科技集团公司第十三研究所
18	中国电子科技集团公司第五十五研究所
19	中国科学院半导体研究所
20	中科钢研节能科技有限公司
21	中晟光电设备（上海）股份有限公司
22	中微半导体设备（上海）有限公司
23	中兴通讯股份有限公司
24	株洲中车时代电气股份有限公司
25	香港应用科技研究院